SCHEDA DATI PER OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA DI CUI AL PUNTO 1.2 DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE N° 187 DELL'11 GIUGNO 2008

Insegnamento:	Elettronica 2
Docente titolare:	Prof.Ing. Giovanni Martines
Qualifica	Professore 1° fascia
SSD di appartenenza	ING-INF/01
Struttura di afferenza	Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica
Telefono	070 675.5766
e-mail	martines@diee.unica.it
Orario di ricevimento	tutti i martedì e giovedì dalle 11:00 alle 13:00
Sito web docente	http://www.diee.unica.it
Curriculum scientifico	Il prof. Martines è autore di più di cinquanta pubblicazioni nel campo delle metodologie e dei sistemi di misura del rumore ad alta frequenza generato nei dispositivi elettronici a stato solido; nel campo della caratterizzazione sperimentale e della modellistica di dispositivi elettronici, orientate non solo al progetto dei circuiti ma anche alla diagnostica e all'individuazione dei meccanismi di guasto; nel campo dello sviluppo della strumentazione elettronica e dei sistemi automatici di misura (ATE). Negli ultimi anni, l'interesse si è esteso al campo delle metodologie di progetto di circuiti integrati monolitici per microonde (MMIC) con particolare riferimento agli oscillatori sinusoidali a impedenza negativa ad alte prestazioni ed ai relativi sistemi di CAD. 1. M. Monni, G. Martines, "A novel approach to determine the start-up conditions in microwave negative impedance oscillator design", Proc. of 37th European Microwave Conference, EUMC '07, IEEE Conference (ISBN 978-2-87487-001-9) pp. 1397-1400, Munich Germany, October 8-12, 2007. 2. M. Giglio, G. Martines, G. Mura, S. Podda, M. Vanzi, "An automated lifetest equipment for optical emitters", Microelectronics & Reliability, vol. 42, n. 9, pp. 1311-1315, September 2002. 3. G. Martines, M. Sannino, "The determination of noise, gain and scattering parameters of microwave transistors (HEMTs) using only an automatic noise figure test-set", IEEE Trans. on Microwave Theory Tech., vol. MTT-42, pp. 1105-13, July 1994. 4. A. Caddemi, G. Martines, M. Sannino, "Automatic characterization and modeling of microwave low-noise HEMTs", IEEE Trans. Instrum. Meas., vol. IM-41, pp. 946 - 950, December 1992.
	5. A. Caddemi, G. Martines, M. Sannino, "HEMT for Low Noise Microwaves: CAD Oriented Modeling", IEEE Trans. on Microwave Theory Tech. (Special Issue on Process-Oriented Microwave CAD and Modeling), vol. MTT-40, pp. 1441-1445, July 1992.
Contenuto schematico del corso di insegnamento	Analisi e progetto di un circuito integrato analogico con particolare riferimento agli amplificatori elettronici a più stadi ed ai loro stadi finali. Progettazione di sistemi elettronici selettivi in frequenza e degli oscillatori sinusoidali.
Obiettivi formativi e	Acquisire conoscenze specifiche sui circuiti integrati elementari con
risultati attesi (secondo i	carichi attivi e polarizzazione con generatori di corrente, sugli
descrittori di Dublino)	amplificatori differenziali e su stadi finali di potenza.
<i>′</i>	

Sapere sviluppare il progetto di un circuito integrato analogico di bassa complessità nelle tecnologie più diffuse scegliendo l'architettura più adeguata alle prestazioni richieste.

Sapere valutare il rapporto costo/benefici delle scelte adottate e la qualità della soluzione ottenuta anche attraverso l'uso di appropriati sistemi di CAD.

Sapere stimare la realizzabilità delle prestazioni richieste ad un circuito integrato analogico e discutere la scelta delle tecnologie e delle soluzioni circuitali più appropriate.

Acquisire la capacità di sviluppare sistemi elettronici complessi a partire da circuiti integrati opportunamente scelti o progettati e valutando nel contempo le prestazioni ottenibili.

Articolazione del corso

<u>Introduzione</u> (2 ore di lezione) Il progetto di un sistema elettronico per la elaborazione analogica dei segnali. Il concetto di costo. La filosofia di progetto dei circuiti integrati analogici.

Amplificatori elementari nei circuiti integrati analogici (8 ore di lezione, 8 ore di esercitazione) Analisi e criteri di progetto di uno stadio amplificatore elementare con carico attivo in tecnologia NMOS, CMOS e bipolare. Specchi di corrente con FET e BJT. Generatori di corrente di Wilson e di Widlar. Coppia differenziale con BJT: funzionamento a largo segnale, caratteristica di trasferimento, analisi a piccolo segnale, offset di tensione e di corrente, correnti di polarizzazione. Calcolo del guadagno differenziale, di modo comune e del CMRR e semplificazione del mezzo circuito equivalente. Coppia differenziale con carico attivo a specchio di corrente e con resistenze sugli emettitori. Coppia differenziale con JFET. Coppie differenziali in tecnologia CMOS. Risposta in frequenza per il segnale differenziale, applicato in modo complementare e non, e per il segnale di modo comune. Variazione del CMRR con la frequenza. Configurazione Darlington. Cascode. Stadi di uscita (5 ore di lezione, 2 ore di esercitazione) Generalità, classificazione e specifiche di progetto: potenza di uscita, distorsione, efficienza di conversione. Analisi e criteri di progetto di uno stadio di uscita in classe A. Criteri per la scelta dei transistori di potenza. Analisi e criteri di progetto di uno stadio di uscita in classe B (push-pull). Distorsione di crossover e relative tecniche di riduzione. Analisi e criteri di progetto di stadi di uscita in classe AB. Protezione da sovraccarico e da surriscaldamento. Analisi di un amplificatore di potenza integrato. Analisi di un amplificatore operazionale integrato.

Il diodo nei circuiti analogici (2 ore di lezione, 1 ora di esercitazione) Concetto di tensione di soglia. Circuiti limitatori, tosatori e di aggancio. Raddrizzatore e rivelatore di picco. Formatori di forma d'onda. Porta campionatrice. Moltiplicatori di tensione. Il "superdiodo" e le sue applicazioni: Raddrizzatore, clamping e rivelatore di picco di precisione. Amplificatore a valore assoluto e logaritmico.

<u>Filtri attivi ed amplificatori selettivi</u> (7 ore di lezione, 3 ore di esercitazione) Generalità e specifiche di progetto. Sintesi di filtri IIR (metodo di Butterworth e Chebyshev). Classificazione delle celle elementari del 1° e del 2° ordine. Circuito di Antoniou per la sostituzione dell'induttore. Celle BIQUAD basate sul circuito di Antoniou. Celle BIQUAD basate sull'anello di reazione con due integratori: KHN e Tow-Thomas. Celle SAB. Stadi elementari di

	,
	amplificatori selettivi. Amplificatori selettivi ad accordo singolo e
	multiplo. Accordo sincrono e a scala
	Oscillatori sinusoidali e generatori di forme d'onda (9 ore di
	lezione, 3 ore di esercitazione) Generalità e specifiche di progetto.
	Criterio di Barkhausen. Stabilità di frequenza e rumore di fase.
	Distorsione e controllo dell'ampiezza in uscita. Analisi e criteri di
	progetto di un oscillatore a sfasamento, di un oscillatore a ponte di
	Wien e di un oscillatore in quadratura. Oscillatori con risonatore:
	analisi e criteri di progetto degli oscillatori di tipo Colpitts e
	Hartley. Risonatore a cristallo (quarzo). Oscillatore di Pierce.
	Principio di funzionamento ed equazioni di progetto dello Schmitt
	trigger. Applicazioni dello Schmitt trigger. Generatori di onda
	quadra e triangolare: principio di funzionamento ed equazioni di
	progetto. Formatore di impulsi: analisi e criteri di progetto,
	specifiche per l'impulso di controllo, esempio di circuito di
	ingresso.
Propedeuticità	Dispositivi Elettronici, Analisi dei Sistemi 1, Analisi dei Sistemi 2,
Tropeacatiena	Elettronica 1
Anno di corso e semestre	1° anno/ 2° sem.
Testi di riferimento	A.S. Sedra, K.C. Smith, "Microelectronic circuits", Oxford
	University Press, Oxford (in italiano "Circuiti per la
	Microelettronica" EdiSES, Napoli).
	R.C. Jaeger, T.N. Blalock "Microelectronic Circuit Design",
	McGraw-Hill, New York (in italiano "Microelettronica: Elettronica
	Analogica" a cura prof. Paolo Spirito, McGraw-Hill Italia, Milano).
	P. Gray, R. Meyer, "Analysis and Design of Analog Integrated
	Circuits", John Wiley, New York (in italiano "Circuiti integrati
	analogici", McGraw-Hill Italia, Milano).
Modalità di erogazione	Tradizionale
dell'insegnamento	
Modalità di frequenza	Obbligatoria
Metodi di valutazione	Prova scritta
Organizzazione della	50 ore, di cui 33 ore di lezione e 17 ore di esercitazione
didattica	